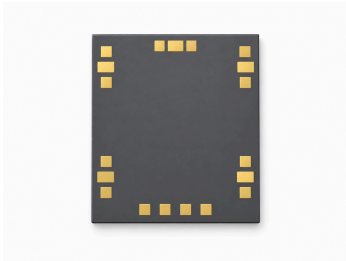


100–20000 MHz GaAs SP4T MMIC 开关裸片 — IL -2 dB (典型值)

100–20000 MHz; 插入损耗 -2 dB (典型值); 隔离度 -50 dB (典型值).



RF 特性 · TA = +25 °C

参数	符号	最小值	典型值	最大值	数值	单位
工作频率	f	100	-	20000	100–20000	MHz
插入损耗	-	-	-2	-	-	dB
隔离度	-	-	-50	-	-	dB
输入驻波比	-	-	1.3	-	-	-
输出驻波比 (导通)	-	-	1.3	-	-	-
输出驻波比 (关断)	-	-	1.3	-	-	-

控制电压

参数	符号	最小值	典型值	最大值	数值	单位
负电源静态电流	-	-	0.0018	-	-	A
输入驱动电流	-	-	0.0003	-	TTL = +5 V	A
输入高电平电压	-	3	-	5	-	V
输入低电平电压	-	0	-	0.4	-	V
负电源电压	-	-	-	-	-5	V

极限参数 · 极限参数，不作为正常工作设定值。

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
最大输入功率	-	-	-	27	dBm
储存温度	-	-65	-	150	°C
工作温度	-	-55	-	85	°C
最大控制电压	-	-	-	6	V
最小负电源电压	-	-6	-	-	V

裸片尺寸

参数	数值	单位
裸片尺寸	$1.6 \times 1.9 \times 0.1$	mm
平面外形尺寸公差	± 100	μm

压点定义

序号	功能符号	mm
2	RFin	0.150×0.100
5	RFout1	0.150×0.100
8	RFout2	0.150×0.100
15	RFout3	0.150×0.100
18	RFout4	0.150×0.100
10, 13	VE	0.100×0.100
11	VA	0.100×0.100
12	VB	0.100×0.100
1, 3, 4, 6, 7, 9, 14, 16, 17, 19	GND	0.100×0.100

当前出版记录 · 1.3 · 2026-10-27. 产品说明或编辑内容更新。替代版本 1.2.

集成说明

VE (V) = -5; VA (V) = 0; VB (V) = 0; RF = RFin $\leftrightarrow$ RFout1 VE (V) = -5; VA (V) = 3.3; VB (V) = 0; RF = RFin $\leftrightarrow$ RFout2 VE (V) = -5; VA (V) = 0; VB (V) = 3.3; RF = RFin $\leftrightarrow$ RFout3 VE (V) = -5; VA (V) = 3.3; VB (V) = 3.3; RF = RFin $\leftrightarrow$ RFout4

压点连接说明

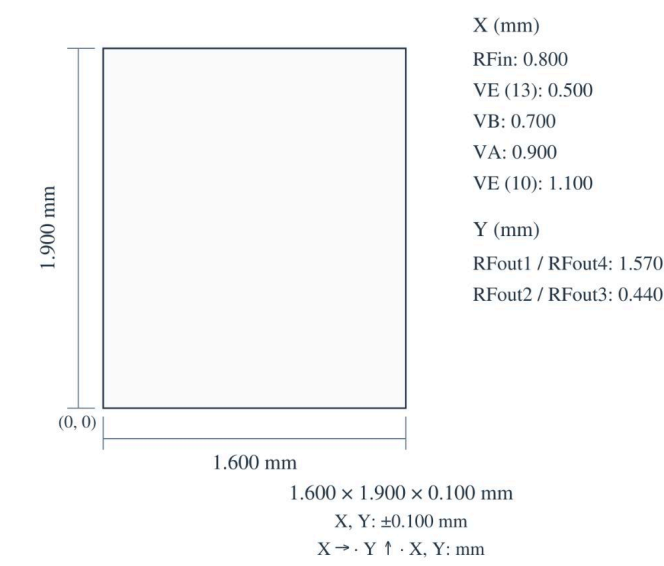
所列GND压点为测试用接地压点。

机械参考图适用范围

依据原资料整理的外形及明确标注坐标参考图，单位 mm；不作为完整制造或键合图。

机械外形尺寸图

LCI-SW-100-20000-SP4T-D



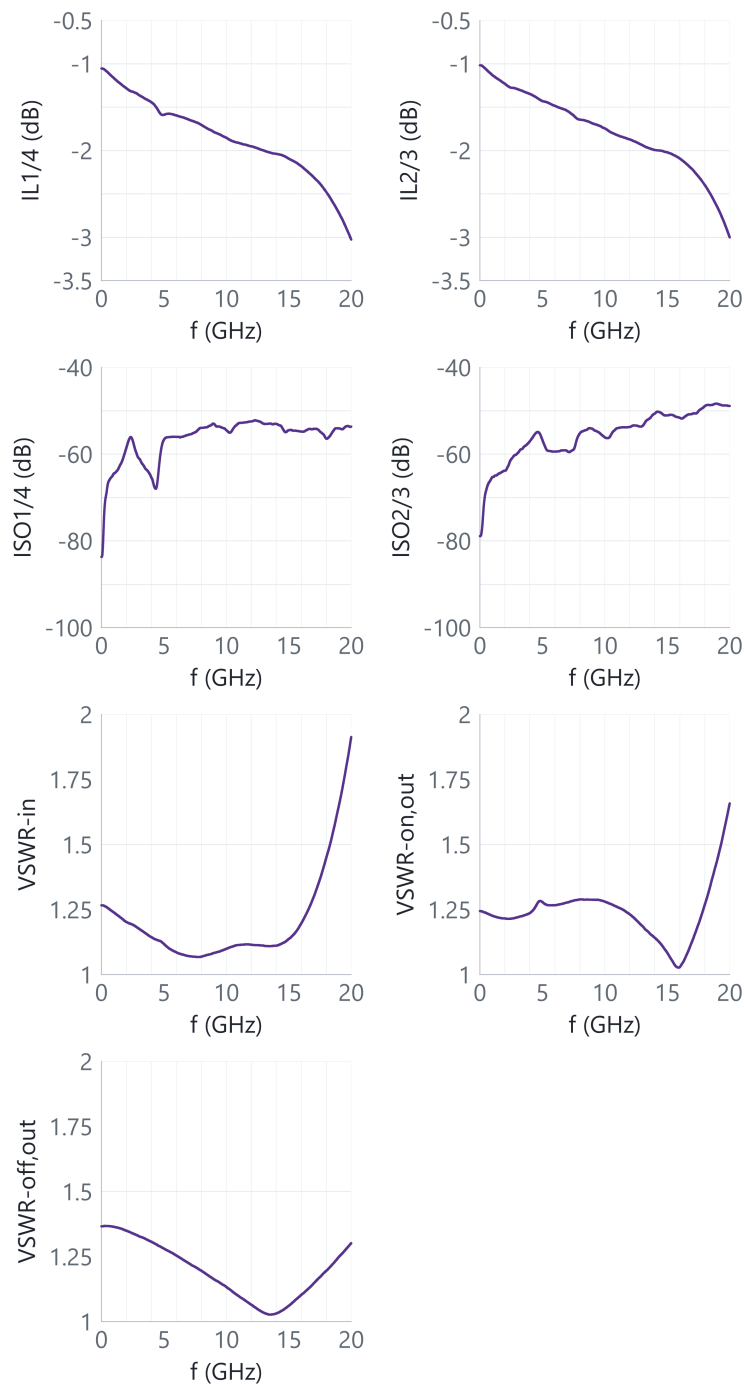
所有尺寸单位为 mm [in]。

性能曲线

以下图表来自原规格书，请结合每张图标明的工作条件阅读。

输出匹配、输入匹配、隔离度、插入损耗。

依照源图曲线重新绘制，图中读数为近似值。



[来源](#)

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。